

关键指标

通带频率: 30.5~32.5GHz

插入损耗: 1.7dB

阻带衰减: 30dB@22.6GHz, 30.7dB@36GHz

回波损耗: 15dB/15dB

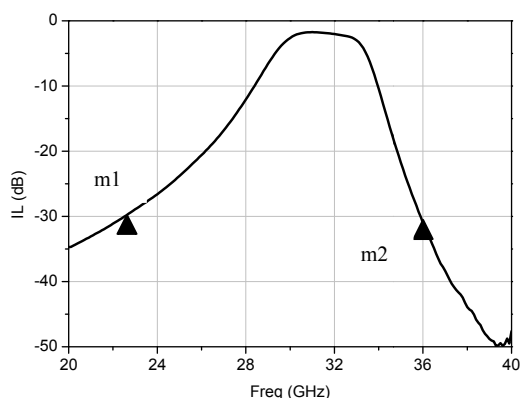
芯片尺寸: 1.5mm×1mm×0.1mm

电性能 (T_A=25℃)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	30.5~32.5		
输入回波损耗(dB)	-	15	-
输出回波损耗(dB)	-	15	-
插入损耗(dB)	-	-	1.7
阻带衰减 @22.6GHz(dB)	-	30	-
阻带衰减 @36GHz(dB)	-	30.7	-

典型测试曲线

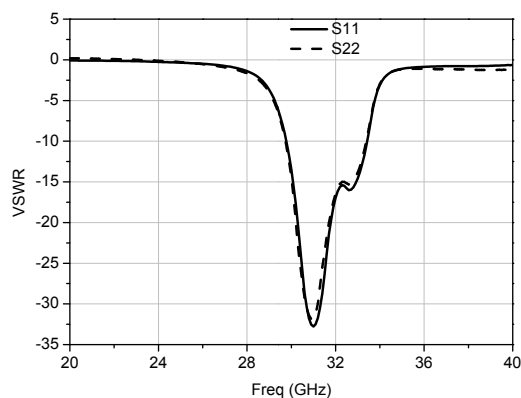
插入损耗



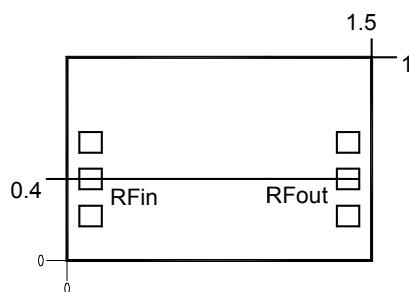
m1
Freq=22.6GHz
dB(S(2,1)) = -30

m2
Freq=36GHz
dB(S(2,1)) = -30.7

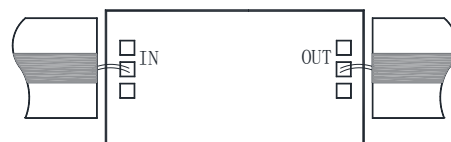
回波损耗



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250~400μm；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。